

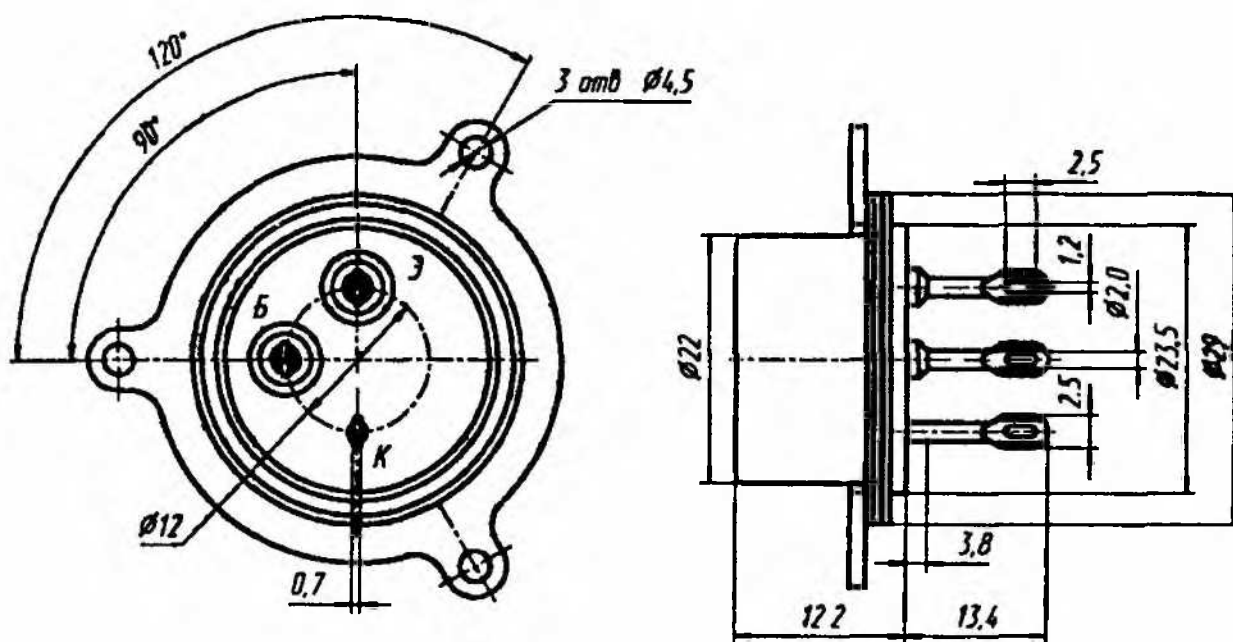
## 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В, ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д

Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные структуры *p-n-p* переключательные. Предназначены для применения в импульсных устройствах, преобразователях и стабилизаторах тока и напряжения. Корпус металлический со стеклянными изоляторами и жесткими выводами.

Масса транзистора не более 28 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.

*1Т806(А-В), ГТ806(А-Д)*



### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ (на границе насыщения):

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В:

при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ .....	10...100
при $T = +70\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 5\text{ А}$ .....	10...100
при $T = -60\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ .....	10...150

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д:

при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ .....	10...100
при $T = +55\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 5\text{ А}$ .....	10...200
при $T = -55\text{ }^\circ\text{C}$ , $I_K = 10\text{ А}$ .....	8...100

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при  $U_{кэ} = 5\text{ В}$ ,  $I_K = 1\text{ А}$ ,

не менее ..... 10 МГц

Граничное напряжение при  $I_3 = 3\text{ А}$ ,

$t_{и} < 50$  мкс,  $f = 20...50$  Гц, не менее:

1Т806А .....	40 В
1Т806Б .....	65 В
1Т806В .....	80 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер, не более:

при $I_k = 20$ А, $I_b = 2$ А для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....	0,6 В
--	-------

при $I_k = 15$ А, $I_b = 2$ А для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .....	0,6 В
--	-------

Напряжение насыщения база—эмиттер, не более:

при $I_k = 20$ А, $I_b = 2$ А для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....	0,8 В
--	-------

при $I_k = 15$ А, $I_b = 2$ А для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .....	1 В
--	-----

Время выключения при  $U_{кз} = 45$  В,  $I_k = 5$  А,  $I_b = 0,25$  А, не более .....

30 мкс

Обратный ток коллектор—эмиттер при  $U_{бэ} = 1$  В,  $U_{кз} = 75$  В для 1Т806А,  $U_{кз} = 100$  В для 1Т806Б,  $U_{кз} = 120$  В для 1Т806В, не более:

$T = +25$ и $-60$ °С .....	12 мА
----------------------------	-------

$T = +70$ °С .....	25 мА
--------------------	-------

$T = +25$  °С,  $U_{кз} = U_{кз, макс}$  для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д.....

15 мА

Обратный ток эмиттера, не более:

при $U_{бэ} = 2$ В для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....	5 мА
---	------

при $U_{бэ} = 1,5$ В для ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .....	8 мА
---	------

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при  $U_{бэ} = 1$  В:

1Т806А, ГТ806А .....	75 В
----------------------	------

1Т806Б, ГТ806Б .....	100 В
----------------------	-------

1Т806В, ГТ806В .....	120 В
----------------------	-------

ГТ806Г .....	50 В
--------------	------

ГТ806Д .....	140 В
--------------	-------

Постоянное напряжение база—эмиттер:

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.....	2 В
-----------------------------	-----

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .....	1,5 В
--	-------

Постоянный ток коллектора в режиме насыщения:

1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В.....	20 А
-----------------------------	------

ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д	15 А
Импульсный ток коллектора в режиме насыщения при $Q \geq 2$ , $t_{и} = 1000$ мкс, $K_{НАС} = 1$ для 1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....	25 А
Постоянный ток базы .....	3 А
Постоянно рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> :	
с теплоотводом, $T_K \leq +25$ °С .....	30 Вт
без теплоотвода, $T \leq +25$ °С .....	2 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус .....	2 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—среда .....	30 °С/Вт
Температура р-п перехода .....	+85 °С
Температура окружающей среды:	
1Т806А, 1Т806Б, 1Т806В .....	-60... $T_K =$ = +70 °С
ГТ806А, ГТ806Б, ГТ806В, ГТ806Г, ГТ806Д .	-55... $T_K =$ = +55 °С

<sup>1</sup> При  $T_K > +25$  °С для транзисторов с теплоотводом

$$P_{K, \text{МАКС}} = (85 - T_K) / R_{T(p-K)}, \text{ Вт};$$

при  $T > +25$  °С для транзисторов без теплоотвода

$$P_{K, \text{МАКС}} = (85 - T) / R_{T(p-C)}, \text{ Вт}.$$

Не допускается отключение базы при наличии напряжения между коллектором и эмиттером. Не рекомендуется работа транзистора при рабочих токах, соизмеримых с неуправляемыми токами во всем диапазоне температур.

Эксплуатация транзисторов в режимах за пределами областей максимальных режимов (в том числе с учетом процессов, происходящих при включении и выключении) запрещается. При работе в импульсном режиме при отсутствии открывающего импульса транзистор должен быть закрыт положительным смещением базы  $0,5 \text{ В} \leq U_{БЭ} \leq 2 \text{ В}$ .

Пайка выводов допускается не ближе 6 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в электрическую цепь, находящуюся под напряжением, коллекторный контакт должен присоединяться последним и отсоединяться первым.